

Г АВЛ.431268.014СБ

Рис.1 (Г АВЛ.431268.014)

(см. продолжение на листах 2, 3)

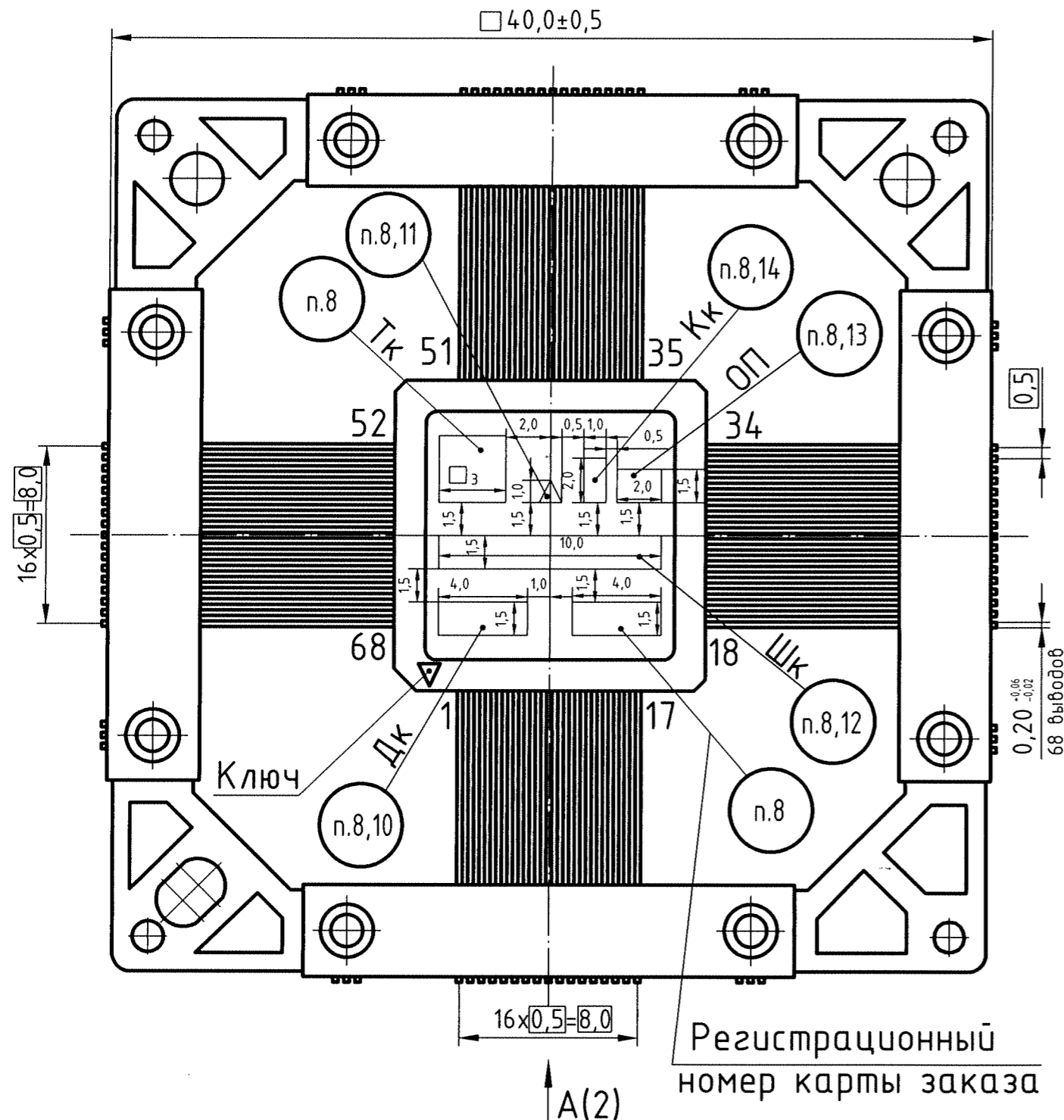


Таблица 1 - Модификация

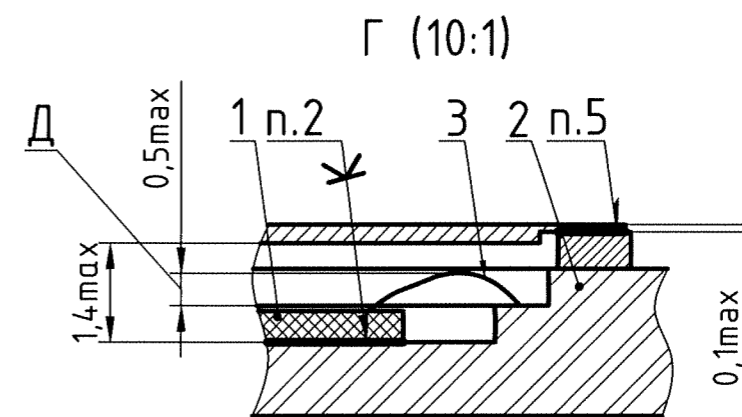
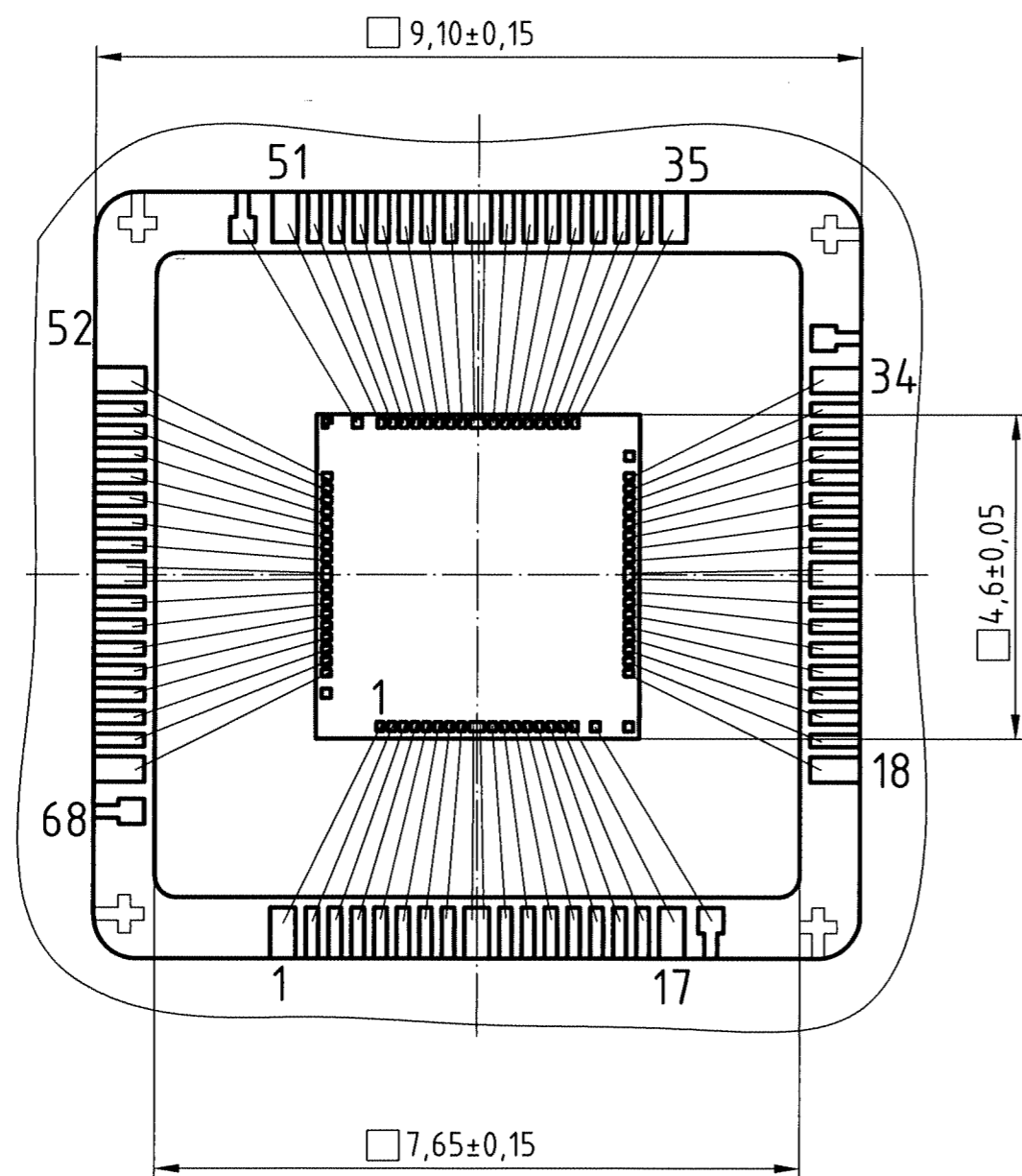
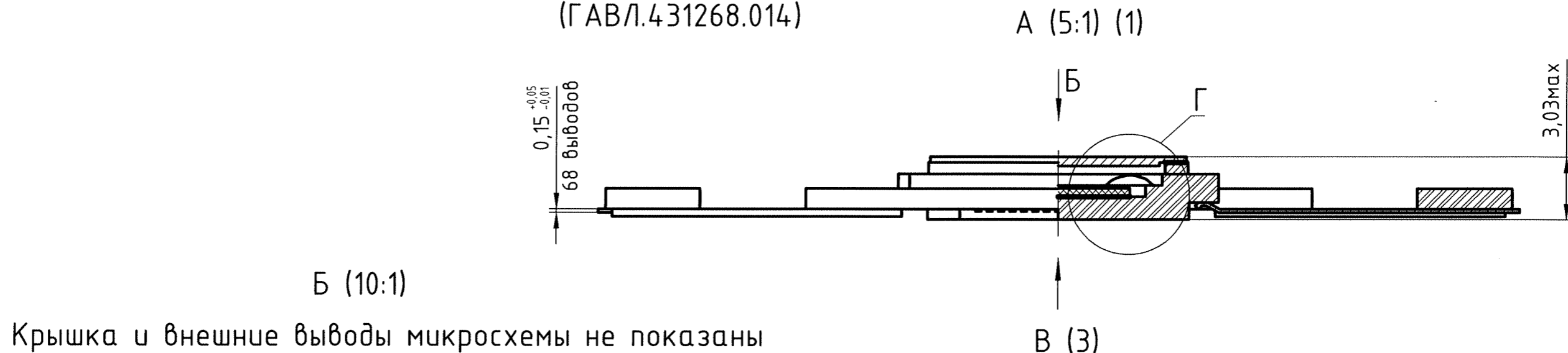
Обозначение	Наименование изделия	Корпус	Маркировка Шк	Масса	Рис.
Г АВЛ.431268.014	5529ТР034	МК 4239.68-2	5529ТР034	max 4,0 г	1
-01	5529ТР034А	МК 4217.44-1	5529ТР034А	max 3,5 г	2

1. Размеры для справок.
2. Кристалл поз.1 клеить к основанию корпуса поз.2 клеем ТОК2 ШКФЛО.028.002ТУ в соответствии с требованиями технологической документации. Не допускается попадание клея на лицевую поверхность кристалла и контактные площадки основания корпуса.
3. Разварку алюминиевой проволоки поз.3 между контактными площадками кристалла и траверсами корпуса производить методом ультразвуковой сварки по РД 11 0274. Не допускается касание проволочным проводником открытых участков кристалла и основания корпуса.
4. Минимальное расстояние между проволочными межсоединениями и незащищенными участками поверхности кристалла должна быть не менее диаметра развариваемой проволоки. Величина Д - максимальная стрела прогиба проводника.
5. Герметизацию корпуса производить методом шовной контактной сварки по РД 11 0274. При этом допускается смещение крышки в пределах ободка основания и наплыв металла по контуру крышки.
6. Показатель герметичности по эквивалентному нормализованному потоку должен быть не более  $6,65 \cdot 10^{-3} \text{ Па} \cdot \text{см}^3/\text{с}$ .
7. Внешний вид микросхем должен соответствовать описанию образцов внешнего вида Г АВЛ.431269.045Д2.
8. Маркировать составом маркировочным эпоксидным черным МКЭЧ-1 РМ11.028.002-83 по ОСТ В 11 0998 Дк, Шк, Нк, ОП, регистрационный номер карты заказа шрифтом ПО-1,5 по ОСТ 11 010.012-74, Тк, Кк, знак Δ согласно основному виду для микросхем 5529ТР034 и шрифтом ПО-1,0 по ОСТ 11 010.012-74 согласно виду Е для микросхем 5529ТР034А. Допускается использовать состав маркировочный эпоксидный черный МКЭЧ РМ11.028.002-83.
9. Допускается маркировка крышки методом лазерной гравировки на глубину не более 1,5 мкм и маркировка основания корпуса методом лазерной гравировки на глубину не более 30 мкм.
10. С обратной стороны маркировать согласно виду В для микросхемы 5529ТР034, виду К для 5529ТР034А.
11. Дк маркировать четырьмя цифрами: две первые цифры обозначают год изготовления (последние две цифры года); две вторые цифры обозначают календарную неделю года.
12. Δ - знак чувствительности к статическому электричеству, равносторонний треугольник.
13. В зоне Шк маркировать согласно таблице 1.
14. Микросхемы опытных партий дополнительно маркируются клеймом ОП.
15. Допускается нанесение клейма ВП и клейма ОП производить одновременно с маркировкой микросхемы.
16. Нумерация выводов приведена условно.
17. Общее содержание драгметаллов в готовом изделии 5529ТР034 соответствует данным этикетки Г АВЛ.431268.014ЭТ, 5529ТР034А - Г АВЛ.431268.014-01ЭТ.
18. Исполнения микросхем приведены в таблице 1.

Инв. № подл. 1537  
 Подп. и дата 20.01.20  
 Взам. инв. № Инв. № дцбл  
 Подп. и дата  
 Справ. №  
 Перв. примен. Г АВЛ.431268.014

Г АВЛ.431268.014СБ						
1	Зам.	Г АВЛ.09-2019	09.12.19	Лит.	Масса	Масштаб
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Микросхемы интегральные	
Разраб.	Астахова	13.11.19		А	5529ТР034, 5529ТР034А	4:1
Пров.	Тукашкин	13.11.19		Лист 1	Сборочный чертеж	Листов 5
512 ВП	Чуриченко	5.12.19				
Н.контр.	Казаков	14.11.19				
Утв.	Денисов	13.11.19				

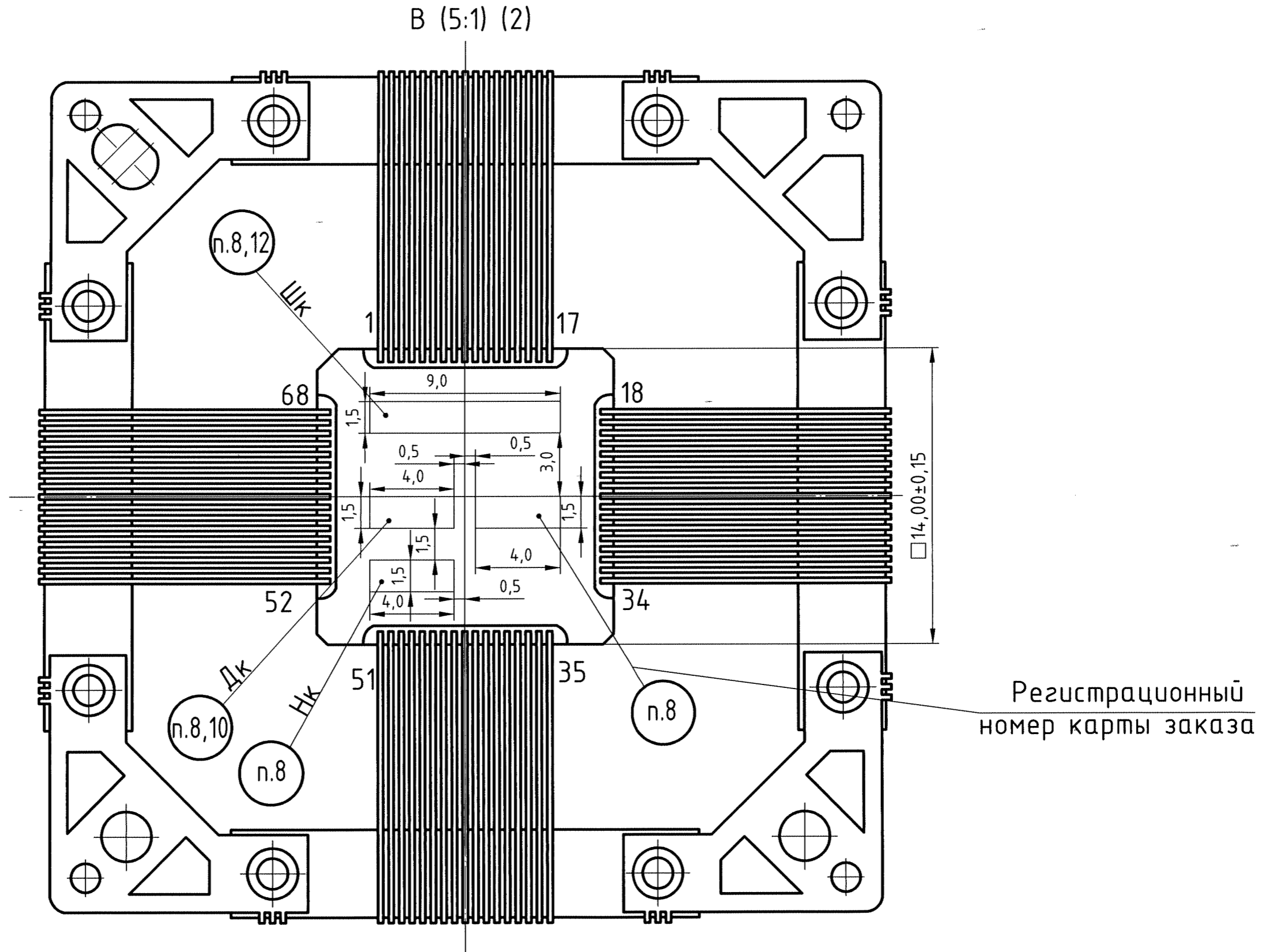
Рис.1 (продолжение)  
(Г АВЛ.431268.014)



Инв. № подл. 1557	Подп. и дата Лит 20.01.2019	Взам. инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата
----------------------	--------------------------------	--------------	-------------	--------------

1	Зам.	Г АВЛ.09-2019	Подп.	Дата
Изм/Лист	Докум.	Подп.	Дата	

Рис.1 (продолжение)  
(ГВЛ.431268.014)



Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата
1557	20.01.20			

1	Зам.	ГВЛ.09-2019	Подп.	Дата
Изм.	Лист	Докум.	Подп.	Дата

ГВЛ.431268.014СБ

Рис.2 (ГВЛ.431268.014-01)

(см. продолжение на листе 5)

Инв. № подл. 1557  
Подп. и дата *Рис. 20.01.20*  
Взам. инв. №/Инв. № дубл.  
Подп. и дата

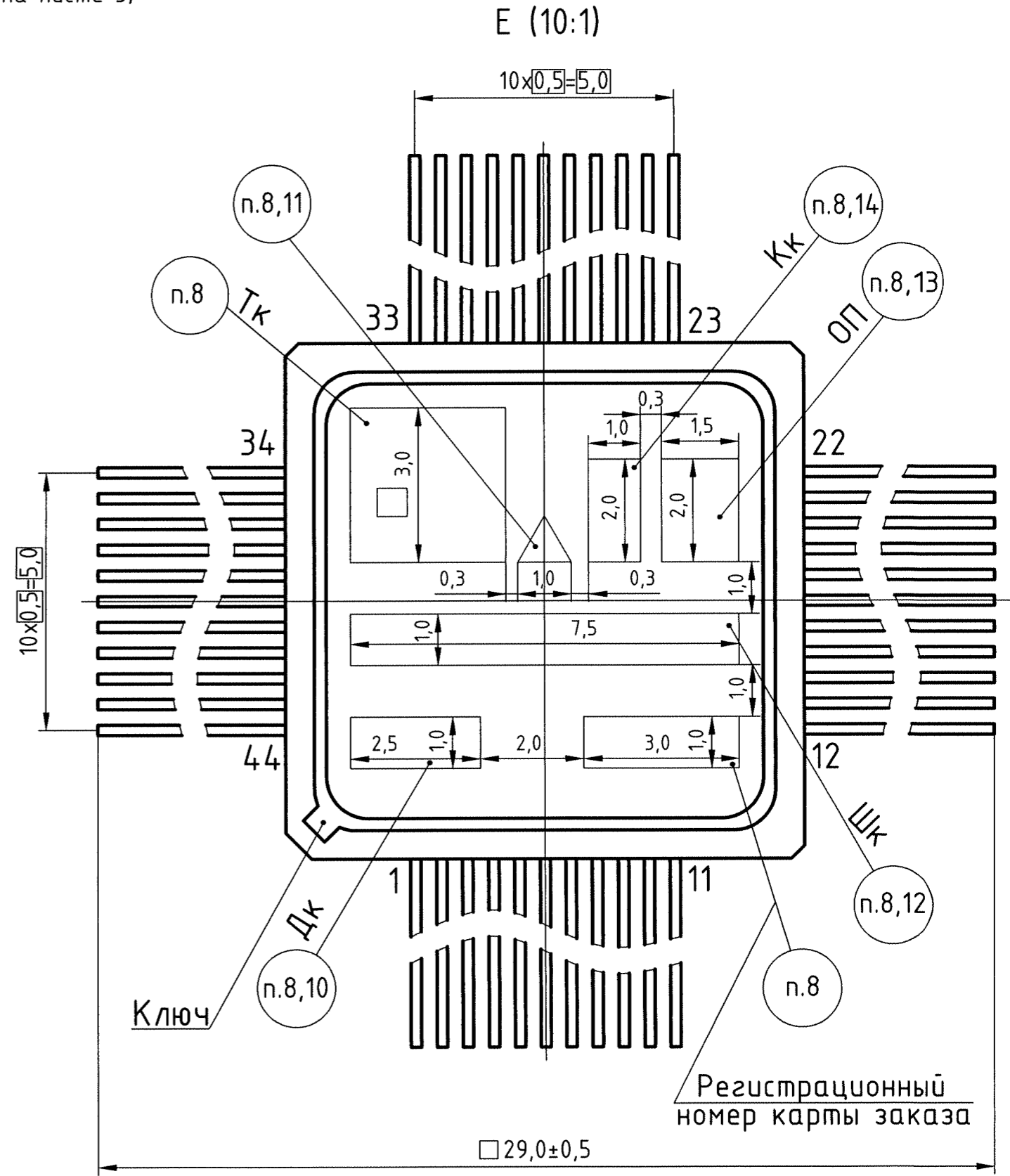
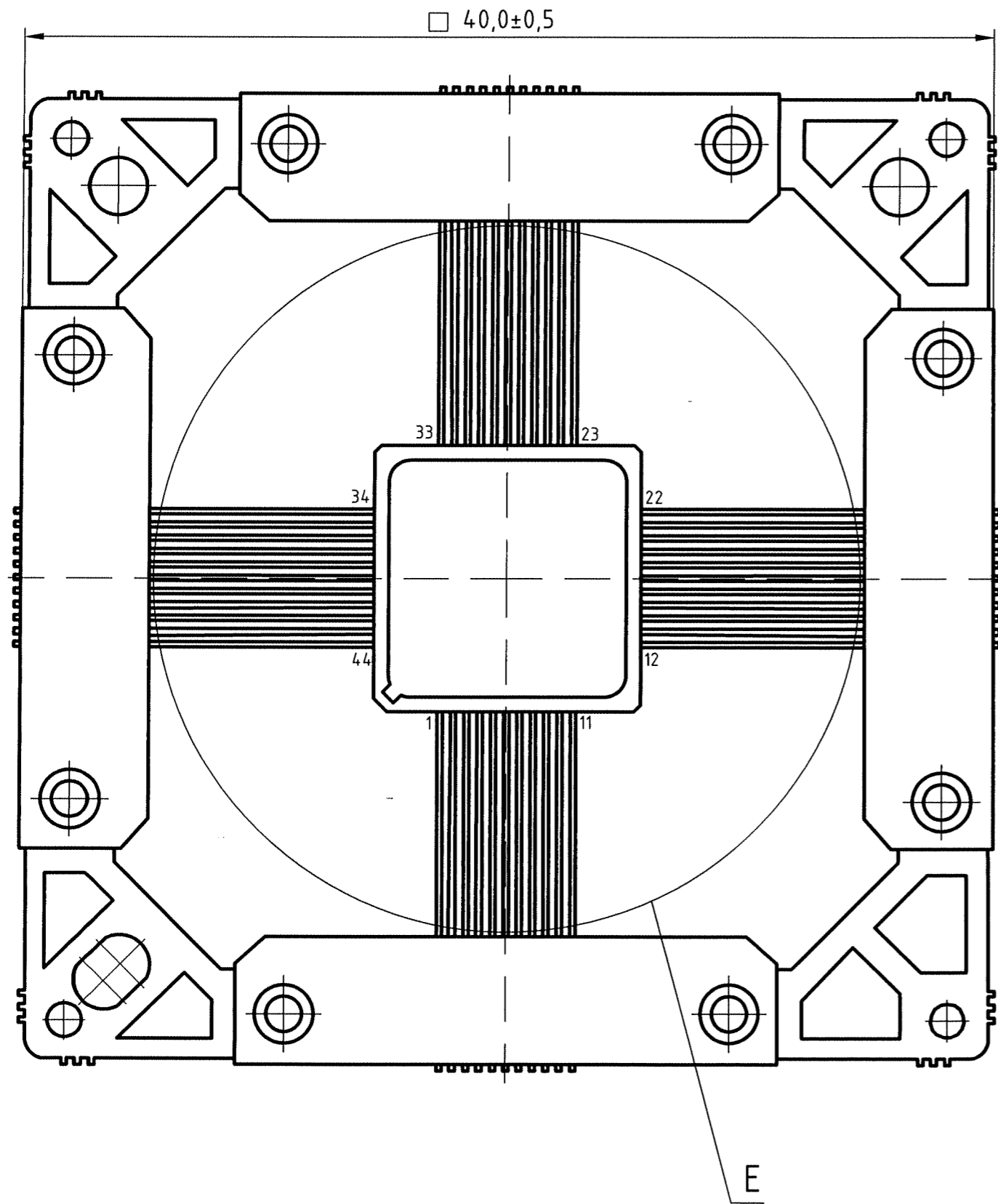
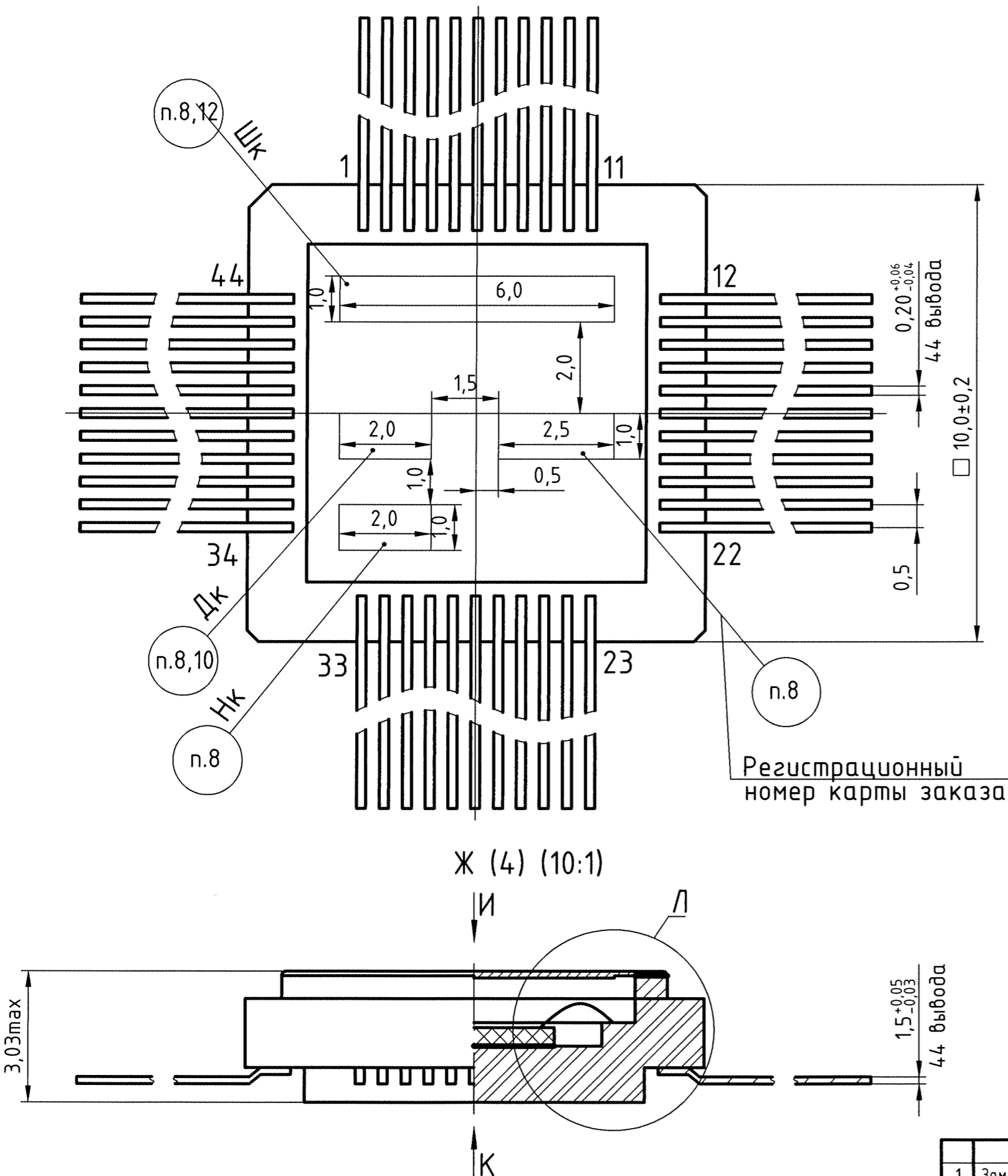
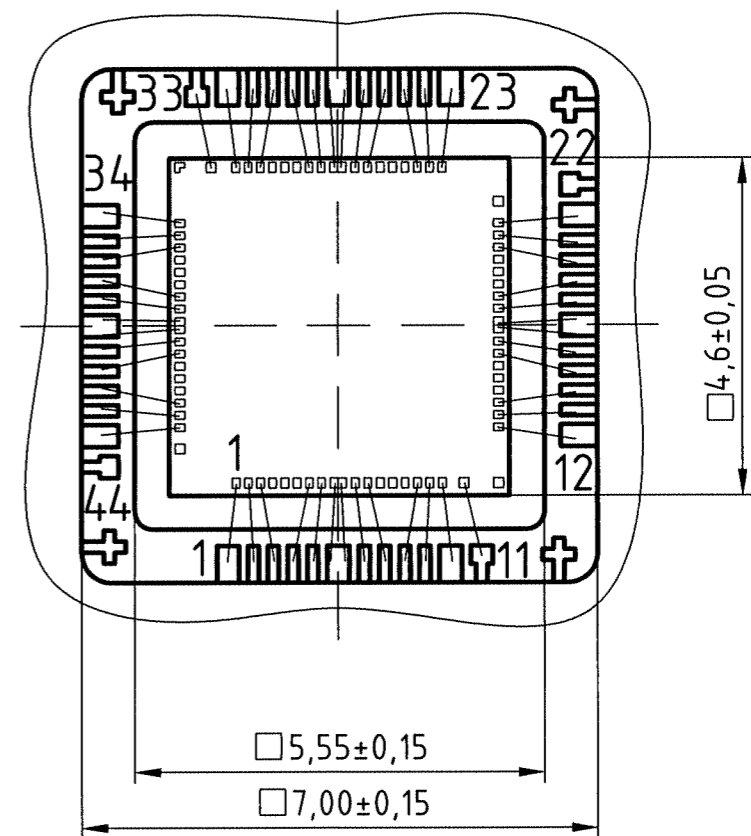


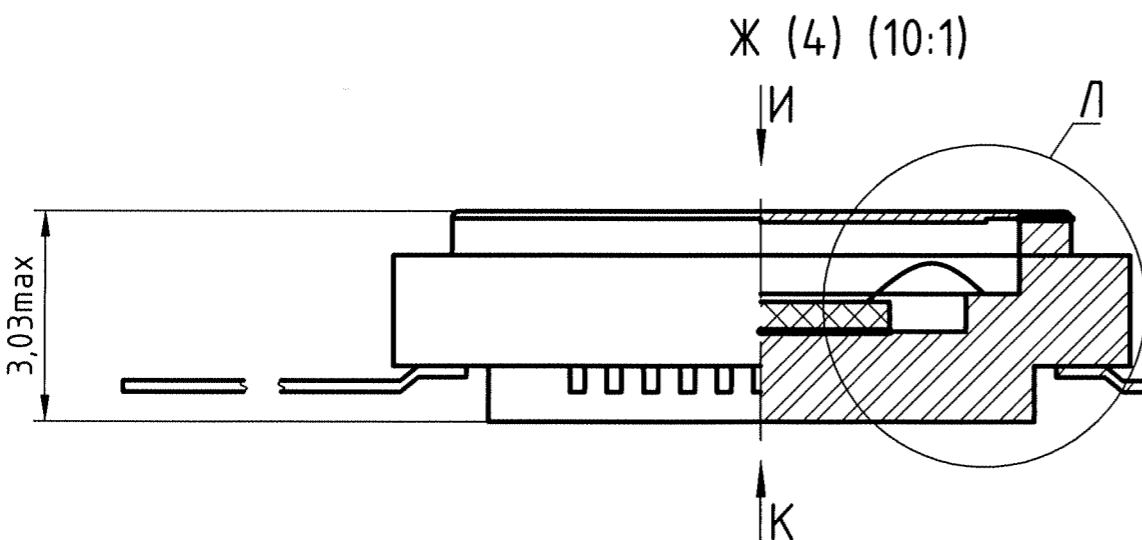
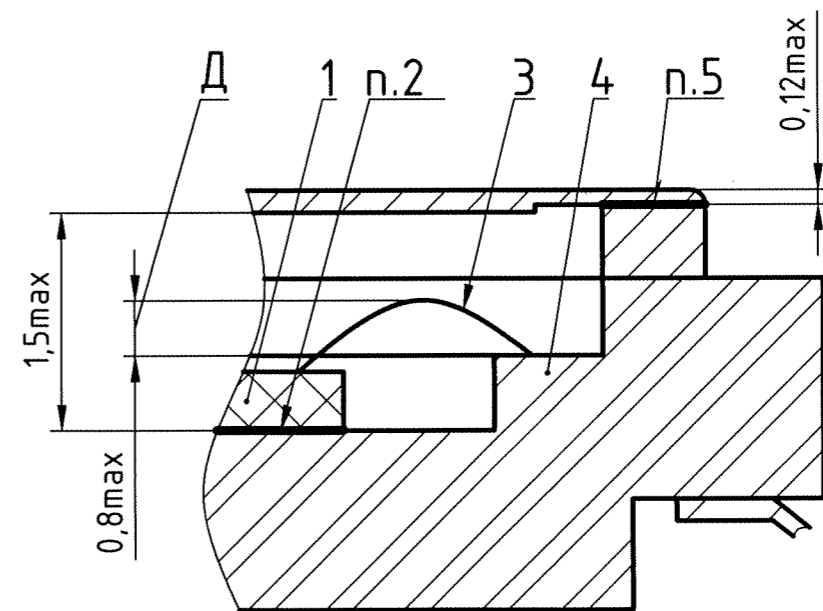
Рис.2 (продолжение)  
(Г АВЛ.431268.014-01)



**И (10:1)**  
Крышка и внешние выводы  
микросхемы не показаны



**Л (20:1)**



Инв. № подл. 7557	Подп. и дата Лит 20.01.88	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
----------------------	------------------------------	--------------	--------------	--------------

1	Зам.	Г АВЛ.09-2019	Подп.	Дата
Изм./Лист	Докум.			